

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCI)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
28 octobre 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/091767 A1**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : B01J 2/00,  
B22F 3/12, C30B 15/02, 29/06

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCI/FR2004/050152

(22) Date de dépôt international : 9 avril 2004 (09.04.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
03/04675 14 avril 2003 (14.04.2003) FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :  
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCI-  
ENTIFIQUE [FR/FR]; 3, Rue Michel Ange, F-75794  
PARIS CEDEX 16 (FR). UNIVERSITE DE POITIERS  
[FR/FR]; 15, Rue de l'Hôtel Dieu, F-86034 POITIERS  
CEDEX (FR)

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : SIRABONI,  
Alain [FR/FR]; 6, Rue Marcel Pagnol, F-86180 BUXE-  
ROLLES (FR)

(74) Mandataire : CABINET MICHEL DE BEAUMONT,  
Michel; 1, rue Champollion, F-38000 GRENOBLE (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire pour tout titre de  
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,  
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,  
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,  
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PH,  
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SI, SY, TJ, TM, TN,  
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire pour tout titre de  
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM,  
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien  
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT,  
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,  
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, IR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, IG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des  
revendications sera republiée si des modifications sont re-  
çues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-  
tions se référer aux Notes explicatives relatives aux codes et  
abréviations figurant au début de chaque numéro ordinaire de  
la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR GRANULES

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION DE GRANULES SEMICONDUCTEURS

(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of semiconductor granules, comprising a step in which semi-  
conductor powders are sintered and/or melted. The powders are nanometric and/or micrometric sized

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication de granules semiconducteurs comportant une étape de frittage et/ou  
de fusion de poudres semiconductrices. Les poudres comprennent des poudres de taille nanométrique et/ou micrométrique.

WO 2004/091767 A1